

KD834



シリコンフォトダイオード

Silicon Photo Diode



概要 Description

KD834 は、プレーナータイプのシリコン・フォトダイオードチップをメタルパッケージに組み込んだフォトダイオードです。

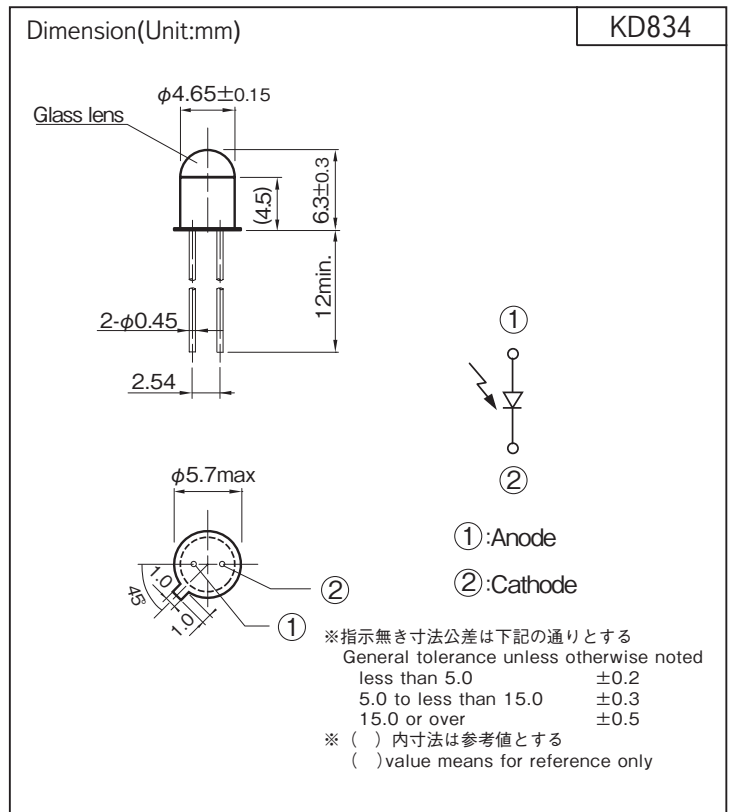
Model KD834 is silicon photodiode mounted in TO-18 type header with lens can.

特長 Feature

- ・ 高感度フォトダイオード (λp:900nm)
- ・ TO-18 メタルパッケージで高性能、高信頼性
- ・ Photo diode (λp:900nm)
- ・ TO-18 package

用途 Application

- ・ フォトセンサ用受光素子
- ・ 光電スイッチ用受光素子
- ・ Photo detector for Photo sensor
- ・ Photo detector for Photoelectric sensor



最大定格 Maximum Ratings [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse Voltage	VR	30	V
許容損失 Power Dissipation	Pd	100	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-25 ~ +125	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-55 ~ +150	°C
半田付温度 Soldering Temperature ※1	Tsol	330	°C

半田付け取扱注意

- ※ 1. キャンパッケージ底面より 2.6mm の位置で 2 秒以内
手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可)
- ※ 2. EV : CIE 標準 A 光源
- ※ 1. Soldering condition less than 2s. at 2.6 mm over
from TO-18 header. Flow Soldering unsupported.
- ※ 2. EV : CIE STD. A Light source

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25°C **]

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
暗電流 Dark Current	Id	VR=10V, EV=0 lx ※2	—	—	10	nA
短絡電流 Short Circuit Current	ISC	EV=100 lx ※2	0.7	1.5	—	μA
ピーク感度波長 Peak Wavelength	λp	—	—	900	—	nm
指向角半値幅 Half Angle	Δθ	—	—	±8	—	deg
応答時間 Response Time	上昇 Rise Time	VR=5V, RL=1kΩ	—	3	—	μs
	下降 Fall Time		—	3	—	

** : Ta=25°C unless otherwise noted

KD834

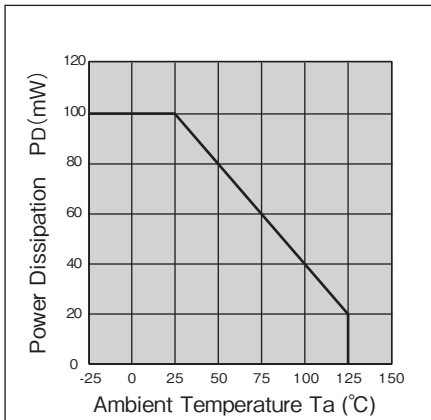
定格・特性曲線

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

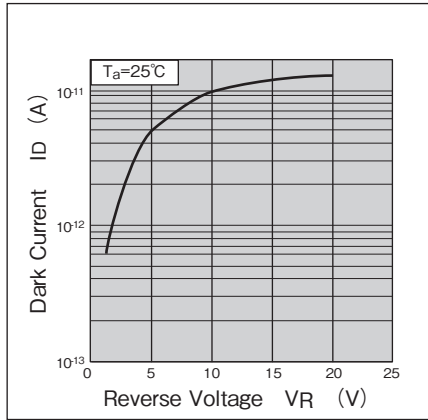
Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

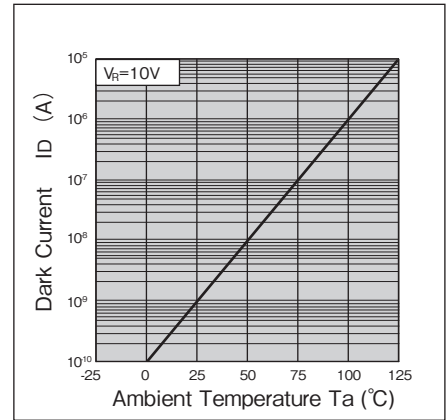
許容損失低減曲線



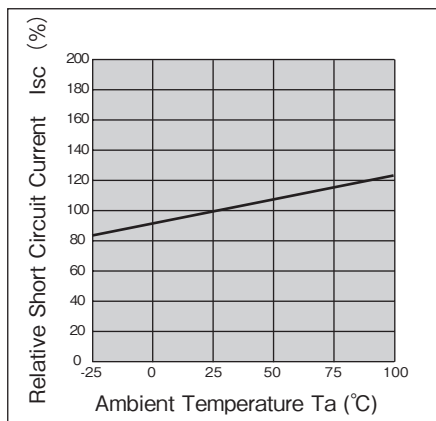
暗電流—逆電圧特性(代表例)



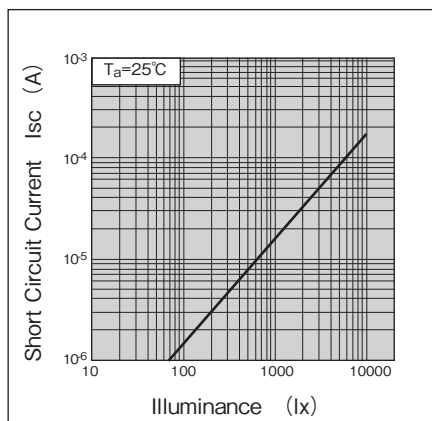
暗電流—周囲温度特性(代表例)



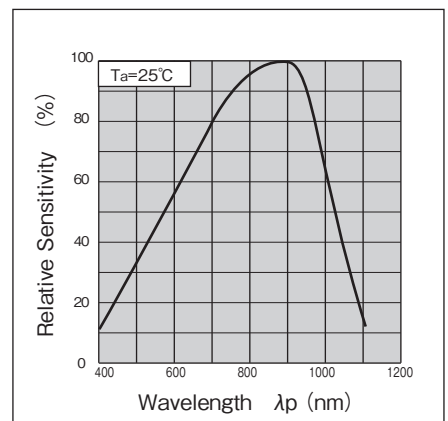
短絡電流—周囲温度特性(代表例)



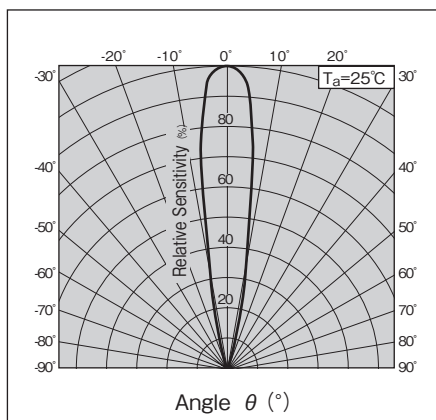
短絡電流—照度特性(代表例)



分光感度特性(代表例)



指向特性(代表例)



- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ A Customized design available on request.
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ Specifications are subject to change without notice.